

第4回 実行委員長 和泉亮 (九州工業大学)

開催 2007年6月29日(金) 午後から 30日(土)

会場: 北九州市立男女共同参画センター"ムーブ"

6月29日

開始	終了	講演題目、発表者(○:登壇者)、所属
13:00	13:10	オープニング
セッション1-1 座長:中山弘(MDF)		
13:10	13:25	01. フラッシュランプアニールにより作製されるボトムゲート型多結晶薄膜トランジスタの開発(1) ○西崎昭吾、遠藤洋平、藤原友子、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
13:25	13:40	02. 超撥水 PTFE 薄膜の作製 ○安岡裕章、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
13:40	14:10	【招待講演】 03. 高温タングステン表面での有機ケイ素のフラグメンテーション 吉村智 1、○木内正人 1,2、竹内孝江 2,3、浜口智志 1 (1 大阪大学、2 産業技術総合研究所、3 奈良女子大学)
14:10	14:25	04. 酸化耐性のある金属キャタライザによるTMAの解離特性 ○荻田陽一郎、工藤嗣友 (神奈川工科大学)
14:25	14:40	05. 酸素/水素混合系触媒分解過程における水素原子の検出 ○梅本宏信 (静岡大学)
14:40	15:00	休憩
セッション1-2 座長:梅本宏信(静岡大学)		
15:00	15:30	【招待講演】 06. 「水素原子と表面の反応」 ○成田克、並木章 (九州工業大学)
15:30	16:00	【招待講演】 07. 原子状水素による EUV ミラーのクリーニング

		○西山岩男 1、齋久実 1、老泉博昭 1、和泉亮 2、並木章 2 (1 技術研究組合超先端電子技術開発機構、2 九州工業大学)
16:00	16:30	【招待講演】 08. 新型両面電極パッケージおよび銅金属粒子直描配線技術の取組 ○石原政道、和泉亮 (九州工業大学)
16:30	16:50	休憩
セッション1-3 座長: 部家彰(兵庫県立大学)		
16:50	17:05	09. Hot-wire を用いた化学輸送成長による Ge 薄膜の作成 ○成田知岐、成瀬恒平、鈴木幾己、飯田民生、小川俊輔、吉田憲充、磯村雅夫、野々村修一 (岐阜大学)
17:05	17:20	10. 熱触媒生成水素ラジカルを用いた EUV リソグラフィ光学系のための Sn クリーニング ○三浦央、酒井朗、弓場愛彦、赤坂洋一 (大阪大学)
17:20	17:35	11. Si-ULSI における Cu 配線への Cat によるラジカル窒化膜の適用 ○武山真弓 1、佐藤勝 1、青柳英二 2、野矢厚 1 (1 北見工業大学、2 東北大学)
17:35	17:50	12. 水素ラジカルを用いたレジスト剥離(3) ○堀邊英夫 1、山本雅史 1、市川智和 2、高尾和久 3、松村英樹 2 (1 金沢工大、2 北陸先端科学技術大学院大学、3 東京応化工業)
18:00	20:00	懇親会 (九州厚生年金会館)

6月30日

開始	終了	講演題目、発表者(○:登壇者)、所属
セッション2-1 座長: 成田克(九州工業大学)		
09:50	10:05	13. Cat-CVD によるカーボンナノチューブ光放射吸収層の作製 ○谷治環、新里雅巳、小野寛方、大谷文雄 (埼玉大学)
10:05	10:20	14. ホットワイヤーCVD 法によるカーボンナノウォール作製におけるバイアス印加効果 ○島袋誠司、畠山雄一、久永優、他田桂一朗、伊藤貴司、野々村修一 (岐阜大学)

10:20	10:50	<p>【招待講演】</p> <p>15. 薄膜の応力とその発生メカニズム ○生地文也 (九州共立大学)</p>
10:50	11:05	休憩
セッション2-2 座長:武山真弓(北見工業大学)		
11:05	11:20	<p>16. ルテニウム担持したタングステン Hot-mesh CVD 法による GaN 膜成長 ○深田祐介 1、小前泰彰 1、黒木雄一郎 1、末光眞希 2、伊藤隆 2、成田克 3、遠藤哲郎 4、中澤日出樹 5、高田雅介 1、安井寛治 1、赤羽正志 1 (1 長岡技術科学大学、2 東北大学学際科学国際高等センター、3 九州工業大学、4 東北大学電気通信研究所、5 弘前大学)</p>
11:20	11:35	<p>17. Cat-CVD 法による裏面電極型 HIT 太陽電池製作の可能性の検討 ○小山晃一、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)</p>
11:35	11:50	<p>18. 第三電極を有するマグネトロンスパッタ法による ZnO 透明導電膜の電気特性の均一性の改善 ○朝野章 1、尾辻美紅 1、山田覚 2、片桐裕 2、増田淳 3、黒木雄一郎 1、安井寛治 1、高田雅介 1、赤羽正志 1 (1 長岡技術科学大学、2 長岡高等工業専門学校、3 産業技術総合研究所)</p>
11:50	12:05	<p>19. 有機金属原料を用いた MO-Cat-CVD 法の開発と応用 ○中山弘、畑強之、伊藤道弘 (マテリアルデザインファクトリー)</p>
12:05	13:10	昼休み
ポスターセッション		
13:10	14:10	<p>【招待講演】</p> <p>20. 石英管で輸送した原子状水素による EUV リソグラフィ用多層膜のクリーニング ○老泉博昭 1,2、壺久実 1、西山岩男 1、宮崎靖雄 2、和泉亮 2、並木章 2 (1 技術研究組合超先端電子技術開発機構、2 九州工業大学)</p> <p>21. Cat-CVD SiN ゲート絶縁膜の TFT 特性の安定化に与える影響 ○西崎昭吾、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)</p>

		<p>22. パルス制御核発生法による Si(001)-2° off 基板上での Ge ナノドットの形成と制御 ○須藤晴紀、荻原智明、西山洋、安井寛治、井上泰宣、赤羽正志、高田雅介 (長岡技術科学大学)</p> <p>23. HWCVD 法により作製した SiCN 膜の XPS 解析 ○松尾亘祐、林祐史、生田哲大、中村郁浩、和泉亮 (九州工業大学)</p> <p>24. HWCVD 法により作製した SiCN 膜の電気容量特性評価 ○林祐史、松尾亘祐、中村郁浩、生田哲大、和泉亮 (九州工業大学)</p> <p>25. Cat-CVD 法による HMDS を用いたガスバリア膜の作製 II ○太田泰広、小柳津拓哉、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)</p> <p>26. 原子状水素を用いたプラスチック基板の表面処理 ○部家 彰、佐藤真彦、松尾直人 (兵庫県立大学)</p>
セッション2-3 座長:大平圭介(北陸先端科学技術大学院大学)		
14:10	14:40	<p>【招待講演】</p> <p>27. Cat-CVD 法による高融点半導体の結晶成長—SiC の低温ヘテロエピ技術— ○安井寛治 (長岡技術科学大学)</p>
14:40	14:55	<p>28. Hot-Mesh CVD 法を用いた極薄 SOI 基板上への 3C-SiC 成長 ○三浦仁嗣 1、安部和貴 1、増田淳 2、黒木雄一郎 1、西山洋 3、安井寛治 1、高田雅介 1、井上泰宣 3、赤羽正志 1 (1 長岡技術科学大学、2 産業技術総合研究所、3 長岡技術科学大学分析センター)</p>
14:55	15:10	<p>29. フィラメント基板間距離を変えて作製したCat-CVD法によるナノ結晶 3C-SiC 薄膜の膜特性 ○田畑彰守 1、香村勇介 1、蘇志成 2、近藤明弘 2 (1 名古屋大学、2 岐阜大学)</p>
15:10	15:30	休憩
セッション2-4 座長:安井寛治(長岡技術科学大学)		
15:30	16:00	【招待講演】

		<p>30. Cat-CVD 技術の基礎と実用化の現状</p> <p>○松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)</p>
16:00	16:15	<p>31. Cat-CVD 用金属キャタライザの耐酸化特性</p> <p>○工藤嗣友、荻田陽一郎 (神奈川工科大学)</p>
16:15	16:30	<p>32. タングステン触媒体のシリサイド化と温度変動に関する考察</p> <p>○本田和広、大平圭介、松村英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)</p>
16:30	16:45	<p>33. プラズマアシスト有機触媒 CVD によるガスバリアフィルムの開発</p> <p>○中山弘、畑強之、伊藤道弘 (マテリアルデザインファクトリー)</p>
16:45	17:00	<p>34. Cat-CVD 法による SiN_x 膜の半導体デバイスへの適用</p> <p>○藤長徹志、山本裕子、高木牧子、橋本正典、浅利伸、斎藤一也 (アルバック)</p>
17:00	17:20	クロージング